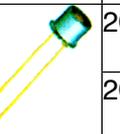


硅光电二极管参数表

外形图	型号	最高工作电压 $V_{RM}(V)$	暗电流 $I_D(\mu A)$	光电流 $I_L(\mu A)$	光电灵敏度 $S_n(\mu A/\mu W)$	接收光峰值波长 $\lambda_P(nm)$	响应时间	
		$I_R = I_D$	$V = V_{RM}$ 无光照	$V = V_{RM}$ $H = 1000LX$ $C = 2850^\circ K$	$V = V_{RM}$ $\lambda_p = 900nm$		上升时间 $t_r(ns)$	下降时间 $t_f(ns)$
	2CU1C	30	≤ 0.1	≥ 80	0.5	880	10	10
	2CU1E	50	≤ 0.1	≥ 80	0.5	880	10	10
	2CU2C	30	≤ 0.1	≥ 30	0.5	880	10	10
	2CU2E	50	≤ 0.1	≥ 30	0.5	880	10	10
	2CU212	30	≤ 1.0	≥ 30	0.5	880	10	10
	2CU213	30	≤ 1.0	≥ 50	0.5	880	50	50
	2CU311A	10	≤ 0.05	≥ 15	0.5	880	50	50
	2CU312A	20	≤ 0.05	≥ 25	0.5	880	50	50
	2CU313A	30	≤ 0.05	≥ 35	0.5	880	50	50
	2CU311B	10	≤ 0.05	≥ 15	0.5	880	50	50
	2CU312B	20	≤ 0.05	≥ 25	0.5	880	50	50
	2CU313B	30	≤ 0.05	≥ 35	0.5	880	50	50

Pin型硅光电二极管参数表

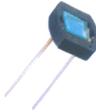
外形图	型号	最高工作电压 $V_{RM}(V)$	暗电流 $I_D(\mu A)$	光电灵敏度 $S_n(\mu A/\mu W)$	响应时间		光电流 $I_L(\mu A)$	光敏区面积 (mm^2)	外形图号
		$I_R = I_D$	$V = V_{RM}$ 无光照	$V = V_{RM}$ $\lambda_p = 900nm$	上升时间 $t_r(ns)$	下降时间 $t_f(ns)$			
	2CU1011	15	≤ 10	0.5	2	2	≥ 2	0.6x0.6	图6
	2CU1012	15	≤ 10	0.5	10	10	≥ 7	1.0x1.0	
	2CU1013	15	≤ 101	0.5	10	10	≥ 15	1.5x1.5	

Pin型硅光电二极管参数表

最高	暗电流	光电	响应时间	光电流	光敏区
----	-----	----	------	-----	-----

外形图	型号	工作电压	暗电流	灵敏度	上升时间	下降时间	光电流	面积 (mm ²)	外形 图号
		V _{RM} (V)	I _D (uA)	Sn(uA/uw)	tr(ns)	tf(ns)	I _L (uA)		
	2CU2011	15	< 10	0.5	10	10	≥7	1.0x1.0	图7
	2CU2022	15	< 10	0.5	10	10	≥15	1.5x1.5	
	2CU2023	15	< 20	0.5	45	45	≥30	2.0x2.0	
	2CU2024	15	< 30	0.5	45	45	≥35	2.5x2.5	
	2CU1025	15	< 30	0.5	50	50	≥50	3.0x3.0	

紫外增强型硅蓝光光电二极管(硅蓝光电池)参数表

外形图	型号	光敏 面积 mm ²	封装 形式	暗电 流	反向耐压	开路电压	短路电压	光电流	响应时间		峰值 波长 λ _p (nm)	蓝光 /峰值 灵敏度比 λ _p = 470nm	外形 图号
				I _D (uA)	V _R (V)	V _{OC} (mV)	I _{SC} (uA)	I _L (uA)	tr(ns)	tf(ns)			
	2CR1133	3X3	陶瓷 带滤 光片	≤0.1	30	≥300	≥25	≥25	50	50	550	≥50	图8
	2CR113-1	3X3	陶瓷	≤0.1	30	≥300	≥40	≥40	50	50	750	≥50	
	2CR1226	3X3	金属 带滤 光片	≤0.1	30	≥300	≥25	≥25	50	50	550	≥50	图9
	2CR1226-1	3X3	金属	≤0.1	30	≥300	≥40	≥40	50	50	750	≥50	

硅光电三极管参数表

外形图	型号	最大 功耗 P _M (MW)	最高 工作电压	暗电流 I _D (uA)	光电流 I _C (mA)	响应时间		接收光 峰值波长 λ _p (nm)	外形 图号
			V _{RM} (V)			上升时间	下降时间		
	3DU111	30	≤10	≤0.3	0.5~1.0	15	15	880	图10
	3DU112	50	≤30	≤0.3					

硅光电三极管参数表

外形图	型号	最大 功耗 $P_M(\text{MW})$	最高 工作电压 $V_{CBO}(\text{V})$	暗电流 $I_D(\mu\text{A})$	光电流 $I_C(\text{mA})$	响应时间		接收光 峰值波长 $\lambda_p(\text{nm})$
						上升时间 $t_r(\text{ns})$	下降时间 $t_f(\text{ns})$	
	3DU111	30	≤ 10	≤ 0.3	0.5~1.0	15	15	880
	3DU112	50	≤ 30	≤ 0.3				
	3DU113	50	≤ 50	≤ 0.3				
	3DU121	30	≤ 10	≤ 0.3	1.0~2.0			
	3DU122	50	≤ 30	≤ 0.3				
	3DU123	50	≤ 50	≤ 0.3				
	3DU131	30	≤ 10	≤ 0.3	≥ 2.0			
	3DU132	50	≤ 30	≤ 0.3				
	3DU133	50	≤ 50	≤ 0.3				
	3DU211	50	≤ 10	≤ 0.3	0.5~1.0	15	15	880
	3DU212	50	≤ 30	≤ 0.3				
	3DU213	80	≤ 50	≤ 0.3				
	3DU221	50	≤ 10	≤ 0.3	1.0~2.0			
	3DU222	50	≤ 30	≤ 0.3				
	3DU223	80	≤ 50	≤ 0.3				
	3DU231	50	≤ 10	≤ 0.3	≥ 2.0			
	3DU232	50	≤ 30	≤ 0.3				
	3DU233	80	≤ 50	≤ 0.3				
	3DU11	50	≤ 10	≤ 0.3	0.5~1.0	15	15	880
	3DU12	50	≤ 30	≤ 0.3				
	3DU13	100	≤ 50	≤ 0.3				
	3DU21	50	≤ 10	≤ 0.3	1.0~2.0			
	3DU22	50	≤ 30	≤ 0.3				
	3DU23	100	≤ 50	≤ 0.3				
	3DU31	50	≤ 10	≤ 0.3	≥ 2.0			
	3DU32	50	≤ 30	≤ 0.3				
	3DU33	50	≤ 50	≤ 0.3				
	3DU801	50	≤ 10	≤ 0.1	≥ 1.0	15	15	880
	3DU802	50	≤ 30	≤ 0.1	≥ 1.5			
	3DU803	100	≤ 50	≤ 0.1	≥ 1.5			

达林顿硅光电三极管参数表

外形图	型号	最大功耗 $P_M(\text{MW})$	最高工作电压 $V_{CBO}(\text{V})$	暗电流 $I_D(\mu\text{A})$	光电流 $I_C(\text{mA})$	响应时间		接收光峰值波长 $\lambda_p(\text{nm})$
						上升时间 $t_r(\text{ns})$	下降时间 $t_f(\text{ns})$	
	3DU501	50	10	≤ 0.5	≥ 5	40	60	900
	3DU502	50	10	≤ 0.5	≥ 15	40	60	900
	3DU511	100	10	≤ 0.5	≥ 5	40	60	900
	3DU512	100	10	≤ 0.5	≥ 15	40	60	900
	3DU531	100	10	≤ 0.5	≥ 5	40	60	900
	3DU532	100	10	≤ 0.5	≥ 15	40	60	900

光电耦合器参数表

外形图	型号	类型	输入部分				输出部分				传输特性			隔离特性				
			$V_F(\text{V})$	$V_R(\text{V})$	$I_{FM}(\text{mA})$	$I_R(\mu\text{A})$	$I_{CBO}(\mu\text{A})$	$V_{CES}(\text{V})$	$I_{CM}(\text{mA})$	$R_{CM}(\text{m}\Omega)$	CTR(%)	$t_r(\mu\text{s})$	$t_f(\mu\text{s})$	$C_{ISO}(\text{PF})$	$R_{ISO}(\Omega)$	$V_{ISO}(\text{V})$		
			$I_F=10\text{mA}$	$I_R=0.1\mu\text{A}$			$V_{CE}=20\text{V}$	$I_F=20\text{mA}$ $I_C=2\text{mA}$ $V_{CE}=10\text{V}$			$I_F=10\text{mA}$ $V_C=10\text{V}$	$V_{CE}=10\text{V}$ $R_L=500(\Omega)$			$V_{ISO}=500\text{V}$ $R_H=60\%$	ACSO HZ 1分钟或 DC		
	GD212	光电二极管输出	≤ 1.5	5	50	≤ 50	≤ 0.1					0.5~1.0	≤ 0.8	≤ 0.8	≤ 1	$\geq 10^{10}$	≥ 1000	
	GD213											1.0~1.5						
	GD214											1.5~2.0						
	GD215											2.0~3.0						
	GD220	光电二极管接受加三极管放大	≤ 1.5	5	50	≤ 50	≤ 0.1	≤ 0.5	25	150	> 20	≤ 0.3	≤ 0.5	≤ 1	$\geq 10^{10}$	≥ 1000		
	GD181	光电三极管输出	≤ 1.5	5	50	≤ 50	≤ 0.1	≤ 0.5	20	100			10~20	≤ 3	≤ 4	≤ 1	$\geq 10^{10}$	≥ 1000
	GD182												20~40					
	GD183												40~60					
	GD184												60~80					
	GD185												80~100					
	GD312	光电三极管输出	< 1.5	5	50	≤ 50	≤ 0.1	≤ 0.5	20	100			20~40	≤ 3	≤ 4	≤ 1	$\geq 10^{10}$	≥ 1000
	GD313												40~60					
	GD314												60~80					
	GD315												80~100					
	GD316												100~120					
GD317	120~150																	
GD318	≥ 150																	
GD331	达林顿输出	< 1.5	5	50	≤ 50	≤ 0.1	≤ 1.5	20	100			100~200	≤ 50	≤ 50	≤ 1	$\geq 10^{10}$	≥ 1000	
GD332												200~500						
GD333												≥ 500						

透射式光电开关参数表

外形图	型号	感应距离 (mm)	缝宽 (mm)	最大正向电流		正向压降 VF(V)	最大功耗 P _{FM} (mW)	反向截止电流	饱和压降 VCES	电流传输比 CTR%	响应时间 μS	外形图号	
				I _{FM} (mA)	I _{CEO} (uA)								
	GK001	1.0	0.5	I _R =5uA	I _F =10mA	60	1.3	100	<0.1	<0.9	>0.5	<8	图16
	GK002	2.0	0.5	60	1.3	100	<0.1	<0.9	>0.5	<8	图17		
	GK104	4.0	0.8	60	1.3	100	<0.1	<0.9	>0.5	<8	图18		
	GK105	5.0	0.6	60	1.3	100	<0.1	<0.9	>0.5	<8	图19		
	GK1010	10.0	4.105	60	1.3	100	<0.1	<0.9	>0.5	<8	图20		
	GK114	4.0	0.6	60	1.3	100	<0.1	<0.9	>0.5	<8	图21		
	GK116	6.0	1.0	60	1.3	100	<0.1	<0.9	>0.5	<8	图22		
	GK118	8.0	1.0	60	1.3	100	<0.1	<0.9	>0.5	<8	图23		

反射式光电开关参数表

外形图	型号	输入部分					输出部分				耦合特性			外形图号	
		正向压降 VF(V)	反向漏电 I _R (uA)	反向耐压 V _R (V)	最大正向电流 I _{FM} (mA)	功耗 P _{FM} (mW)	暗电流 I _{CEO} (uA)	最大工作电压 V _{CE} (V)	最大输出电流 I _{FM} (mA)	功耗 P _{FM} (mw)	传输比 CTR %	饱和压降 V _{ces}	响应时间		
		V _F =10mA	V _R =5V	I _R =5uA	I _{FM} (mA)	(mW)	V _{CE} =10V	I _{CEO} =100uA	I _F =20mA V _{ce} =10v	I _c =100uA			Tr (us)		Tf (us)
	GK6002A	≤1.3	≤5	>5	30	60	≤0.1	30	30	60	4~6	≤0.4	3	4	图24
	GK6002B	≤1.3	≤5	>5	30	60	≤0.1	30	30	60	6~8	≤0.4	3	4	
	GK6002C	≤1.3	≤5	>5	30	60	≤0.1	30	30	60	≥8	≤0.4	3	4	

*CRT为输出电流I_C与输入电流I_F之比，测试时用白纸距端面5mm测试。

光纤耦合传感器参数表

外形图	型号	结构	输入特性		输出特性			传输特性				外形图号	
			正向压降 $V_F(V)$	最大正向电流 $I_{FM}(mA)$	暗电流 $I_{CEO}(\mu A)$	工作电压 $V_{CE}(V)$	功耗 $P_{fm}(mw)$	输出电流 $I_{FM}(mA)$	最大工作电压 $V_{CE}(V)$	响应时间			光纤长度
										$T_r(\mu s)$	$T_f(\mu s)$		
			$V_F=20mA$		$V_{CE}=10V$	$I_{CE0}=100\mu A$	$I_F=20mA$ $I_C=100\mu A$	$I_F=20mA$ $I_C=100\mu A$		$V_{CE}=10V$ $R_L=500\Omega$			
	GX205	光二极管 输出对射	≤ 2.3	50	≤ 0.05	≥ 20	75	≥ 20	20	0.08	0.10	0.5	图24
	GX210		≤ 2.3	50	≤ 0.0	≥ 20	75	≥ 20	20	0.08	0.10	1.0	
	GX250		≤ 2.3	50	≤ 0.05	≥ 20	75	≥ 20	20	0.08	0.10	5.0	
	GX2100		≤ 2.3	50	≤ 0.05	≥ 20	75	≥ 20	20	0.08	0.10	10.0	
	GX2200		≤ 2.3	50	≤ 0.05	≥ 20	75	≥ 20	20	0.08	0.10	20.0	
	GX305	光三极管 输出对射	≤ 2.3	50	≤ 0.1	≥ 20	75	≥ 20	20	3	4	0.5	
	GX310		≤ 2.3	50	≤ 0.1	≥ 20	75	≥ 20	20	3	4	1.0	
	GX350		≤ 2.3	50	≤ 0.1	≥ 20	75	≥ 20	20	3	4	5.0	
	GX3100		≤ 2.3	50	≤ 0.1	≥ 20	75	≥ 20	20	3	4	10.0	
	GX3200		≤ 2.3	50	≤ 0.1	≥ 20	75	≥ 20	20	3	4	20.0	